

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 6 月 16 日 (2005.6.16)

【公開番号】特開 2002-299315 (P2002-299315A)
 【公開日】平成 14 年 10 月 11 日 (2002.10.11)
 【出願番号】特願 2001-95306 (P2001-95306)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/3065

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/304

【F I】

H 0 1 L 21/302 A

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/304 6 4 5 C

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 9 月 17 日 (2004.9.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

半導体基板を含む複数の被処理基体群を半導体製造装置を用いて一群ずつ処理する方法であって、前記方法は、

順次処理される少なくとも第 1 及び第 2 の被処理基体群を含む前記複数の被処理基体群を用意し、

前記第 1 及び第 2 の被処理基体群の処理タイプに基づいて、前記第 2 の被処理基体群を処理する前に前記半導体製造装置に対して所定の措置を施す必要があるか否かを判断し、

所定の措置を施す必要がない場合、前記所定の措置を施さずに前記第 2 の被処理基体群を処理することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

半導体基板を含む複数の被処理基体群を半導体製造装置を用いて一群ずつ処理する方法であって、前記方法は、

複数の被処理基体群を用意し、

最初の被処理基体群の後に処理する、残りの被処理基体群のうち、前記最初の被処理基体群の処理が終了した後に、前記半導体製造装置に対して所定の措置を施さずに処理を行える少なくとも 1 つの被処理基体群を抽出し、この抽出した被処理基体群を前記最初の被処理基体群の後に処理することを特徴とする半導体装置の製造方法。